(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
18. März 2010 (18.03.2010)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2010/028825 A3

(51) Internationale Patentklassifikation:
H01L 21/00 (2006.01) *H01L 21/311* (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2009/006566

(22) Internationales Anmeldedatum:
10. September 2009 (10.09.2009)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2008 048 540.3
15. September 2008 (15.09.2008) DE

(71) Anmelder *(für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US)*: **GEBR. SCHMID GMBH & CO.** [DE/DE]; Robert-Bosch-Strasse 32-34, 72250 Freudenstadt (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder *(nur für US)*: **HABERMANN, Dirk** [DE/DE]; Keltenring 110, 79199 Kirchzaarten (DE).

(74) Anwalt: **RENGER, Florian**; Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner, Kronenstrasse 30, 70174 Stuttgart (DE).

(81) Bestimmungsstaaten *(soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart)*: AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten *(soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart)*: ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— *mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)*

— *vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)*

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts:
18. November 2010

(54) Title: METHOD FOR THE TREATMENT OF SUBSTRATES, SUBSTRATE AND TREATMENT DEVICE FOR CARRYING OUT SAID METHOD

(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUR BEHANDLUNG VON SUBSTRATEN, SUBSTRAT UND BEHANDLUNGSEINRICHTUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES VERFAHRENS

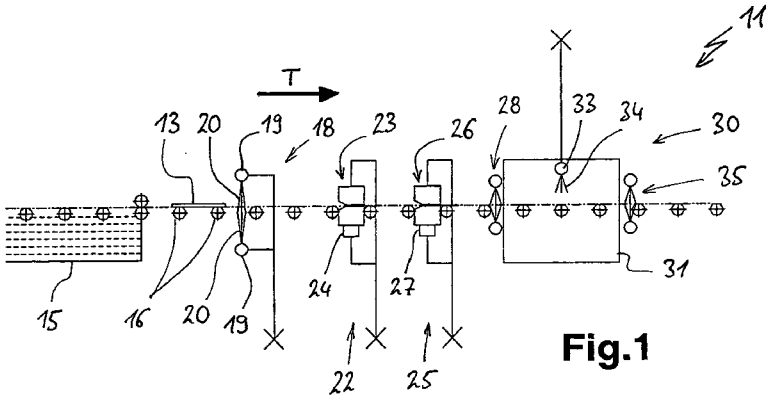

Fig.1

(57) Abstract: In a method for treating substrates (13) for silicon solar cells, the substrates are cleaned with deionized water (18) following multiple etching processes. The substrates (13) are then dried and heated in drying stations (22, 25), whereupon the heated substrates (13) are oxidized in an oxidation station (30) by means of an oxidizing gas having a percentage of ozone.

(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zur Behandlung von Substraten (13) für Solarzellen aus Silizium werden nach mehrfachem Ätzen die Substrate mit Dl- Wasser gereinigt (18). Anschließend werden die Substrate (13) in Trockenstationen (22, 25) getrocknet und erwärmt. Danach werden die erwärmten Substrate (13) in einer Oxidationsstation (30) mit Oxidationsgas (34) mit einem Ozon-Anteil oxidiert.

WO 2010/028825 A3